

研究評価委員会
「次世代半導体微細加工・評価基盤技術の開発」(事後評価) 分科会
議事要旨

日 時：平成28年6月21日(火) 9:30~18:00

場 所：大手町サンスカイルーム A室

〒100-0004 東京都千代田区大手町2-6-1 朝日生命大手町ビル 27階

出席者(敬称略、順不同)

<分科会委員>

分科会長	宮本 岩男	東京理科大学 基礎工学部電子応用工学科 嘱託教授
分科会長代理	石原 直	東京大学 工学系研究科 学術戦略室 上席研究員
委員	泉谷 渉	株式会社産業タイムズ社 代表取締役社長
委員	上野 巧	信州大学 ファイバーイノベーション・インキュベータ施設 特任教授
委員	河合 晃	長岡技術科学大学大学院 教授 電気電子情報工学専攻 電子デバイス・フォトニクス工学講座
委員	笹子 勝	パナソニック株式会社オートモティブ&インダストリアルシステムズ社直轄 技術本部 デバイスインキュベーション推進室 室長
委員	渋谷 真人	東京工芸大学 工学部メディア画像学科 教授

<推進部署>

都築 直史	NEDO IoT 推進部 部長
波佐 昭則	NEDO IoT 推進部 主任研究員
片岡 茂	NEDO IoT 推進部 主査

<実施者※メインテーブル着席者のみ>

森 一朗(PL)	株式会社 EUVL 基盤開発センター 顧問
石内 秀美	株式会社 EUVL 基盤開発センター 代表取締役社長
渡辺 秀弘	株式会社 EUVL 基盤開発センター 研究連携推進部 担当部長
田中 聡	株式会社 EUVL 基盤開発センター 研究連携推進部 担当部長
井谷 俊郎	株式会社 EUVL 基盤開発センター 研究連携推進部 担当部長
塩原 英志	株式会社 EUVL 基盤開発センター 研究連携推進部 担当部長
東 司	株式会社 EUVL 基盤開発センター 研究連携推進部 担当部長
福永 健二	株式会社 EUVL 基盤開発センター 企画業務部 部長
増富 理	株式会社 EUVL 基盤開発センター 企画業務部 担当部長

<評価事務局等>

佐藤 義竜	NEDO 技術戦略研究センター 研究員
徳岡 麻比古	NEDO 評価部 部長
駒崎 聰寛	NEDO 評価部 主査

議事次第

(公開セッション)

1. 開会、資料の確認
2. 分科会の設置について
3. 分科会の公開について
4. 評価の実施方法について
5. プロジェクトの概要説明
 - 5.1 事業の位置付け・必要性、研究開発マネジメント
 - 5.2 研究開発成果、成果の実用化・事業化に向けた取り組み及び見通し
 - 5.3 質疑応答

(非公開セッション)

6. プロジェクトの詳細説明
 - 6.1 EUVマスクブランク欠陥検査技術開発
 - 6.2 EUVマスクパターン欠陥検査技術開発
 - 6.3 EUVレジスト材料技術開発
 - 6.3-① EUVレジスト材料技術開発
 - 6.3-② アウトガス測定方法
 - 6.3-③ DSA技術開発
7. 成果の実用化・事業化に向けた取り組み及び見通しについて
 - 7.1 EUVマスクブランク欠陥検査装置事業計画 レーザーテック株式会社
 - 7.2 EUVマスクブランク欠陥検査装置事業計画 株式会社荏原製作所
 - 7.3 EUVブランク事業計画 HOYA株式会社
 - 7.4 EUVマスク事業計画 大日本印刷株式会社
 - 7.5 EUVレジスト事業計画(2社) JSR株式会社・富士フイルム株式会社
 - 7.6 メモリ事業へのEUVL技術適用計画 株式会社東芝
8. 全体を通しての質疑応答

(公開セッション)

9. まとめ・講評
10. 今後の予定、その他
11. 閉会

議事要旨

(公開セッション)

1. 開会、資料の確認
 - ・配布資料確認(事務局)
2. 分科会の設置について
 - ・研究評価委員会分科会の設置について、資料1に基づき事務局より説明。

・出席者の紹介（評価事務局、推進部署）

3. 分科会の公開について

評価事務局より資料2及び3に基づき説明し、議題6.「プロジェクトの詳細説明」議題7.「成果の実用化・事業化に向けた取り組み及び見通しについて」議題8.「全体を通しての質疑応答」を非公開とした。

4. 評価の実施方法について

評価の手順を評価事務局より資料4-1～4-5に基づき説明した。

5. プロジェクトの概要説明

5.1 事業の位置付け・必要性、研究開発マネジメント

推進部署より資料6-1-1に基づき説明が行われ、その内容に対し質疑応答が行われた。

5.2 研究開発成果、成果の実用化・事業化に向けた取り組み及び見通し

実施者より資料6-1-2に基づき説明が行われ、その内容に対し質疑応答が行われた。

(非公開セッション)

6. プロジェクトの詳細説明

6.1 EUVマスクブランク欠陥検査技術開発

6.2 EUVマスクパターン欠陥検査技術開発

6.3 EUVレジスト材料技術開発

上記の説明に対し質疑応答が行われた。

7. 成果の実用化・事業化に向けた取り組み及び見通しについて

7.1 EUVマスクブランク欠陥検査装置事業計画 レーザーテック株式会社

7.2 EUVマスクブランク欠陥検査装置事業計画 株式会社荏原製作所

7.3 EUVブランク事業計画 HOYA株式会社

7.4 EUVマスク事業計画 大日本印刷株式会社

7.5 EUVレジスト事業計画（2社） JSR株式会社・富士フイルム株式会社

7.6 メモリ事業へのEUVL技術適用計画 株式会社東芝

8. 全体を通しての質疑応答

(公開セッション)

9. まとめ（講評）

10. 今後の予定

11. 閉会

配布資料

資料 1	研究評価委員会分科会の設置について
資料 2	研究評価委員会分科会の公開について
資料 3	研究評価委員会分科会における秘密情報の守秘と非公開資料の取り扱いについて
資料 4-1	NEDOにおける研究評価について
資料 4-2	評価項目・評価基準
資料 4-3	評点法の実施について
資料 4-4	評価コメント及び評点票
資料 4-5	評価報告書の構成について
資料 5-1	事業原簿（公開）
資料 5-2	事業原簿（非公開）
資料 6-1-1~2	プロジェクトの概要説明資料（公開）
資料 6-2-1~3	プロジェクトの詳細説明資料（非公開）
資料 7-1~6	成果の実用化・事業化に向けた取り組み及び見通しについて
資料 8	今後の予定
参考資料 1	NEDO技術委員・技術委員会等規程
参考資料 2	技術評価実施規程

以上